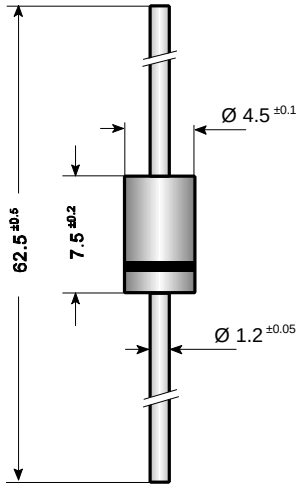
Silicon-Power-Z-Diodes **Silizium-Leistungs-Z-Dioden**



Dimensions / Maße in mm

Nominal breakdown voltage Nenn-Arbeitsspannung	8.7…200 V
Standard tolerance of Z-voltage Standard-Toleranz der Arbeitsspannung	± 5 % (E24)
Plastic case – Kunststoffgehäuse	~ DO-201
Weight approx. – Gewicht ca.	1 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	see page 17 siehe Seite 17

Standard Z-voltage tolerance is graded to the international E 24 standard.
Other voltage tolerances and higher Z-voltages on request.

Die Toleranz der Arbeitsspannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen Reihe E 24. Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.

Maximum ratings — Grenzwerte

Z-voltages see table on next page
Arbeitsspannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite

Power dissipation Verlustleistung	T_A = 25 °C	P_{tot}	5.0 W [1])
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	– 50…+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	– 50…+175°C

Characteristics — Kennwerte

Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft	R_{thA}	< 25K/W [1])

[1]) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Maximum ratings — Grenzwerte

Type Typ	Zener volt.[2]) Arbeitsspg.[2]) $I_Z = I_{Z\,test}$ U_Z [V]	Test current Meßstrom $I_{Z\,test}$ [mA]	Dynamic resistance Inhär.diff. Widerstand $I_Z = I_{Z\,test}$ r_{zj} [Ω]	I_Z = 1 mA	Reverse volt. Sperr spanng. I_R = 0.5 µA U_R [V]	Surge current Stoßstrom t_p = 8.3 ms I_{ZS} [A]	Max. Z-current[1]) Arbeitsstrom[1]) T_A = 45°C I_Z [mA]
1N 5345B	8.7	150	2	200	>6.6 (10 µA)	9.5	545
1N 5346B	9.1	150	2	150	>6.9 (7.5 µA)	9.2	520
1N 5347B	10	125	2	125	>7.6 (5 µA)	8.6	475
1N 5348B	11	125	2.5	125	>8.4 (5 µA)	8.0	430
1N 5349B	12	100	2.5	125	>9.1 (2 µA)	7.5	395
1N 5350B	13	100	2.5	100	>9.9 (1 µA)	7.0	365
1N 5351B	14	100	2.5	75	>10.6 (1 µA)	6.7	340
1N 5352B	15	75	2.5	75	>11.5 (1 µA)	6.3	315
1N 5353B	16	75	2.5	75	>12.2 (1 µA)	6.0	295
1N 5354B	17	70	2.5	75	>12.9	5.8	280
1N 5355B	18	65	2.5	75	>13.7	5.5	264
1N 5356B	19	65	3	75	>14.4	5.3	250
1N 5357B	20	65	3	75	>15.2	5.1	237
1N 5358B	22	50	3	75	>16.7	4.7	216
1N 5359B	24	50	3	100	>18.2	4.1	198
1N 5360B	25	50	4	110	>19.0	4.3	190
1N 5361B	27	50	5	120	>20.6	4.1	176
1N 5362B	28	50	6	130	>21.2	3.9	170
1N 5363B	30	40	8	140	>22.8	3.7	158
1N 5364B	33	40	10	150	>25.1	3.5	144
1N 5365B	36	30	11	160	>27.4	3.3	132
1N 5366B	39	30	14	170	>29.7	3.1	122
1N 5367B	43	30	20	190	>32.7	2.8	110
1N 5368B	47	25	25	210	>35.8	2.7	100
1N 5369B	51	25	27	230	>38.8	2.5	93
1N 5370B	56	20	35	280	>42.6	2.3	86
1N 5371B	60	20	40	350	>45.5	2.2	79
1N 5372B	62	20	42	400	>47.1	2.1	76
1N 5373B	68	20	44	500	>51.7	2.0	70
1N 5374B	75	20	45	620	>56.0	1.9	63
1N 5375B	82	15	65	720	>62.2	1.8	58
1N 5376B	87	15	75	760	>66.0	1.7	54.5
1N 5377B	91	15	75	760	>69.2	1.6	52.5
1N 5378B	100	12	90	800	>76.0	1.5	47.5
1N 5379B	110	12	125	1000	>83.6	1.4	43
1N 5380B	120	10	170	1150	>91.2	1.3	39.5
1N 5381B	130	10	190	1250	>98.8	1.2	36.5
1N 5382B	140	8	230	1500	>106	1.2	34
1N 5383B	150	8	330	1500	>114	1.1	31.6
1N 5384B	160	8	350	1650	>122	1.1	29.4
1N 5385B	170	8	380	1750	>129	1.0	28
1N 5386B	180	5	430	1750	>137	1.0	26.4
1N 5387B	190	5	450	1850	>144	0.9	25
1N 5388B	200	5	480	1850	>152	0.9	23.6

[1]) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

[2]) Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen